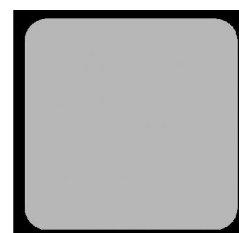


碳化硅肖特基功率二极管芯片
特性:

- 正温度系数，易于并行使用
- 不受温度影响的开关特性
- 超快开关
- 高频应用
- 零反向恢复电流
- 零正向恢复电压

产 品 概 览		
V_{RRM}	3300	V
$I_F, T_C=140^{\circ}\text{C}$	5	A
Q_C	59	nC


额定值

参数	标识	测试条件	数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		3300	V
反向浪涌峰值电压	V_{RSM}		3300	
反向直流电压	V_{DC}		3300	
正向平均电流	I_F	$T_C=140^{\circ}\text{C}$	5	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, $t_p=10\text{ms}$, Half sine Pulse	15	A
正向不重复峰值电流	I_{FSM}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, $t_p=10\mu\text{s}$, Pulse	90	A
工作温度	T_j		-55°C to 175°C	$^{\circ}\text{C}$
贮藏温度	T_{stg}		-55°C to 175°C	$^{\circ}\text{C}$

电学特性，无特殊说明时结温 $T_j=25^{\circ}\text{C}$

参数	标识	测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向压降	V_F	$I_F=5\text{A}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	2.4	3	V
		$I_F=5\text{A}$, $T_j=175^{\circ}\text{C}$	-	4	6	
反向电流	I_R	$V_R=3000\text{V}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	20	100	μA
		$V_R=3000\text{V}$, $T_j=175^{\circ}\text{C}$	-	40	200	
总存储电荷	Q_C	$V_R=2200\text{V}$, $T_j=150^{\circ}\text{C}$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dV$	-	59	-	nC
总电容	C	$V_R=0\text{V}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, $f=1\text{MHz}$	-	413	435	pF
		$V_R=1000\text{V}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, $f=1\text{MHz}$	-	18	19	
		$V_R=2000\text{V}$, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, $f=1\text{MHz}$	-	13.5	14	

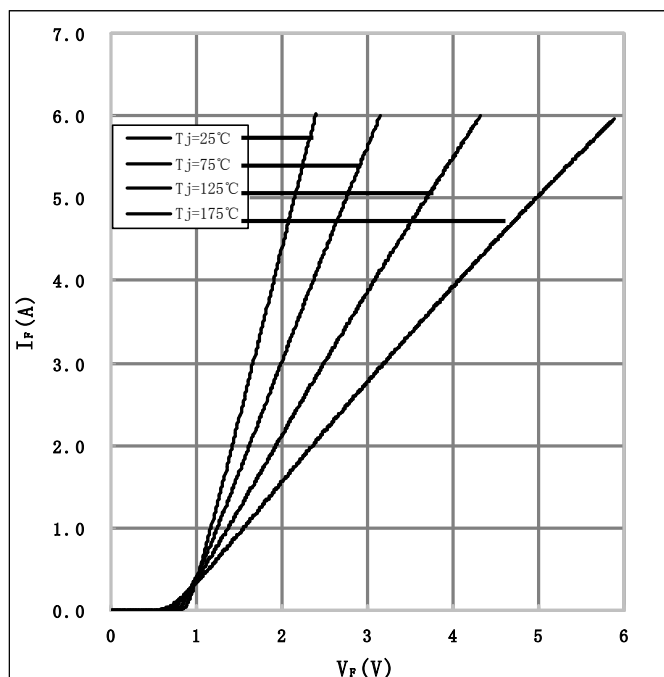


图 1. 典型正向特性
 $I_F=f(V_F)$, 结温 T_j 为参数

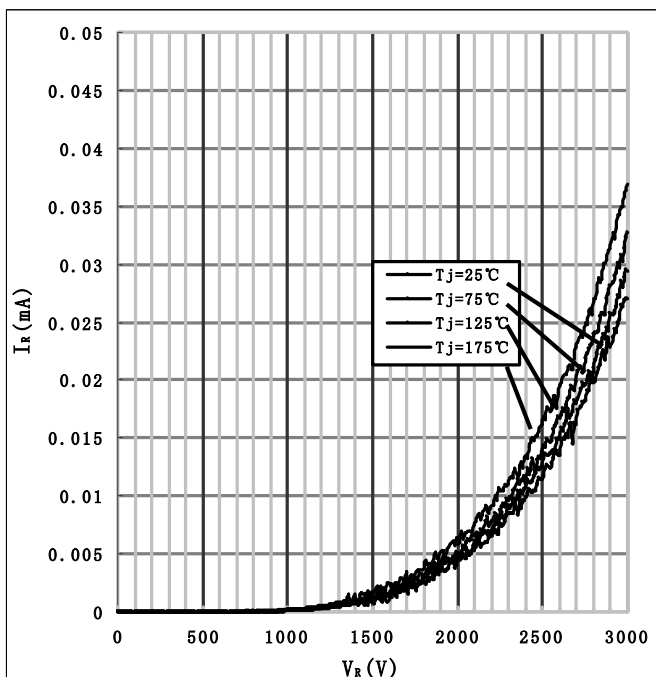


图 2. 典型反向特性
 $I_R=f(V_R)$, 结温 T_j 为参数

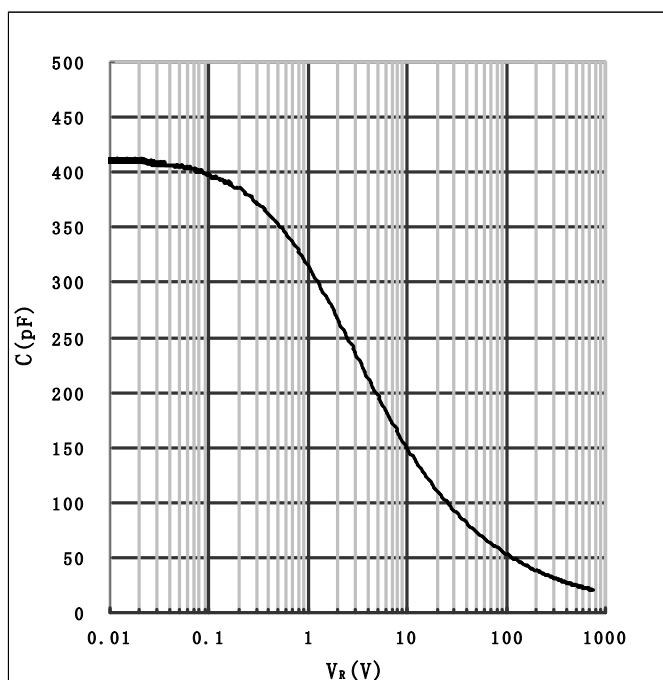
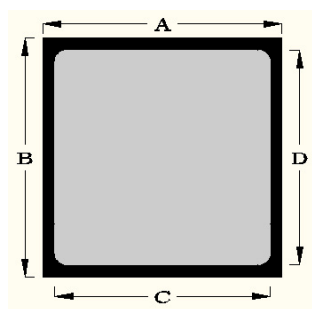


图 3. 恢复电容

结构尺寸

参数	尺寸	单位
芯片尺寸	2.6*2.5	mm
阳极金属尺寸	1.96*1.86	mm
阳极窗口	1.52*1.42	mm
厚度	375±25	um
晶圆尺寸	100	mm
阳极金属厚度（铝）	4	um
阴极金属厚度（银）	1.2	um
正面保护层	聚酰亚胺	

芯片尺寸



符号	尺寸	
	mm	inch
A	2.6	0.1
B	2.5	0.1
C	1.52	0.06
D	1.42	0.06

型号	阳极	阴极	出货方式
GW2-S33005	Al	Ag	芯片盒

Contact us:

[Global Power Technology Co.,Ltd.](#)

Address : Dongsheng Technology Park, Bldg. B-1 West, 66Xixiaokou Road, Haidian
District, Beijing, China, 100192

Website : www.globalpowertech.cn

E-mail : qiuqi@globalpowertech.cn

Tel : +86-10-82156180/82156177

Fax : +86-10-82156218